

	<h2 style="color: red;">SISS23DN-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SISS23DN-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 50A PPAK 1212-8S
	Datenblätter:  SISS23DN-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

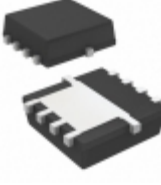

Spezifikationen

Teilenummer	SISS23DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 50A PPAK 1212-8S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8S (3.3x3.3)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 20A, 4.5V
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 57W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Andere Namen	SISS23DN-T1-GE3CT
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8840pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	300nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 50A (Tc) 4.8W (Ta), 57W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	50A (Tc)

SISS23DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISS23DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISS23DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SISS23DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISS12DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SISS26DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHANNEL 60V 60A 1212-8S</p>	 <p>SISS10DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS27ADN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 50A 1212-8</p>
 <p>SISS23DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 50A PPAK 1212-8S</p>	 <p>SISS27DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>	 <p>SISS27ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 50A POWERPAK1212</p>	 <p>SISS23DN-T1-E3 VISHAY VISHAY PAK1212</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISS23DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISS23DN-T1-GE3 Datenblatt	SISS23DN-T1-GE3-Datenblätter	SISS23DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISS23DN-T1-GE3
SISS23DN-T1-GE3 Electronic	SISS23DN-T1-GE3-Komponenten	SISS23DN-T1-GE3-Verteiler	SISS23DN-T1-GE3-Bild	SISS23DN-T1-GE3-Teil
SISS23DN-T1-GE3 Preis	SISS23DN-T1-GE3 Hersteller	SISS23DN-T1-GE3 Bild	SISS23DN-T1-GE3 Aktie	SISS23DN-T1-GE3 Inventar
SISS23DN-T1-GE3 Neu	SISS23DN-T1-GE3 Original	SISS23DN-T1-GE3 garantiert	SISS23DN-T1-GE3 RFQ	SISS23DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited